

Hi3516AV300 DDR3 参数配置方法 S版本 00B01 control steether is 10 miles in 10 miles i

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明

(上) AISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有多,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
Rectification

The approximation of the control of the contro 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本	2; \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Hi3516A	V300	9

读者对象

修订记录

本文档(本指南)主要适用于以下式程师:

• 技术支持工程师

• 软件开发工程师

修订记录素积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2019-06-13	00B01	第一次临时版本发布



前	言		i
目	录		ii
 4 TI			
ΙH	li3516AV300 DDR3 驱动配置说明	•	
	1.1 Hi3516AV300 DDR3 CLK/AC 驱动配置方法		1
	1.2 Hi3516AV300 DDR3 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法		1
	1.3 Hi3516AV300 DDR3 读方向 DQS/DQ 驱动配置方法	- chole	2
2 H	1.2 Hi3516AV300 DDR3 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法	<i>ر</i> ه	3
	2.1 Hi3516AV300 DDR3 写方向 DQS/DQ ODT 配置	-	3
	2.1.1 写方向 ODT 使能		3
	2.1.2 写方向 ODT 大小配置		3
	2.1.2 写方向 ODT 大小配置		4
	2.2.1 读方向 ODT 使能		4
	2.2.1 读方向 ODT 使能		4
3 H	li3516AV300 DDR3 容量配置说明		
	3.1 DDR3 uboot 表格说明		5
	3.2 DMEB(2133Mbps)。		<i>6</i>
	3.2.2 DMEB(213 Mbps)方案一配置说明		
	3.3 DMEB(1800 ps)单板容量修改说明		7
	3.3.1 DMEB(1800Mbps)方案一配置说明		7
	3.4 DMEBPRO 单板容量修改说明		8
	3.4.1 DMFRPRO 方案一配置说明		ç

Hi3516AV300 DDR3 驱动配置说明

1.1 Hi3516AV300 DDR3 CLK/AC 驱动配置方法

Fishi chanting Industrial Technology Co. 寄存器地址 DDR PHY: 0x1206d018 寄存器描述 - Bit[25:23]:CK 驱动 - Bit[22:20]:2T 驱动 - Bit[19:17]:1T 驱动 驱动大小定义

- - 000: Disable
 - 001: 240ohm
 - 010: 120ohm
 - 011: 80ohm
 - 100: 600hm
 - 10**16** 480hm
 - ₩10: 40ohm

1T 信号指 CKE、CSN、ODT、RESET, 2T 信号指的是除 1T 外的其他 AC 信号。

1.2 Hi3516AV300 DDR3 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法

寄存器地址

DDR PHY: 0x1206d204(byte0, byte1) 0x1206d304(byte2, byte3)

- 寄存器描述
 - Bit[16:14]: 写方向 DQS 驱动

- Bit[13:11]: 写方向 DQ 驱动
- 驱动大小定义
 - 000: Disable
 - 001: 240ohm
 - 010: 120ohm
 - 011: 80ohm
 - 100: 60ohm
 - 101: 48ohm
 - 110: 40ohm
 - 111: 34ohm

1.3 Hi3516AV300 DDR3 读方向 DQS/DQ 驱动配置方法

- 寄存器地址
 - DDR PHY: 0x1206c064
- 寄存器描述

Hi3516AV300 DDR3 ODT 配置说明

2.1 Hi3516AV300 DDR3 写方向 DQS/DQ ODT 配置

2.1.1 写方向 ODT 使能

2.1.2 写方向 ODT 大小配置

写方向 ODT 大小定义

(%) 000: ODT 美闭

- 001: 60ohm

- 010: 120ohm

- 011: 40ohm

注意

写方向 ODT 配置对于 DQS 和 DQ 信号同时生效。

2.2 Hi3516AV300 DDR3 读方向 DQS/DQ ODT 配置

2.2.1 读方向 ODT 使能

寄存器地址

DDR PHY: 0x1206d248(byte0, byte1) 0x1206d348(byte2, byte3)

寄存器描述

- Bit[3]=0: 读方向 **ODT 打开** - Bit[3]=1: 读方向 **ODT 关闭**

2.2.2 读方向 ODT 大小配置

寄存器地址

DDR PHY: 0x1206d204(byte0, byte1)

0x1206d304(byte2, byte3)

寄存器描述

- Bit[31:29]: 读方向 DQS 的 ODT

- Bit[28:26]: 读方向 DQ 的 ODT

读方向 ODT 大小定义

- 000: Disable

- 001: 120ohm

- 010: 60ohm

- 011: 40ohm

- 100: 30ohm

101: 249hm

110c 20ohm

- 250nm - 170hm

OT Industrial Technology Co., Ltd.

3 Hi3516AV300 DDR3 容量配置说明

3.1 DDR3 uboot 表格说明

Hi3516AV300 存储器接口在对接 DDR3 的时候,支持最大数据位宽 32bit,单通道模式。关于 DDR 的相关配置都是在 uboot 表格中实现的。对i3516AV300 发布的 DDR3 有三个表格,分别对应 DMEB 单板(2133Mbps)、DMEB 单板(1800Mbps)、DMEPRO单板的设计。

- DMEB uboot 表格(2133Mbps): Hi3516AV300-DMEB_4L_FLYBY-DDR3_2133M_512MB_16bitx2-A7_900M-SYSBUS_300M
- DMEB uboot 表格(1800Mbps): Hi3516AV300-DMEB_4L_FLYBY-DDR3_1800M_1GB_16bitx2-A5 900M-SYSBUS_300M
- DMEBPRO uboot 表格: H3516AV300-DMEBPRO_6L_T-DDR3_1800M_1GB_16bx2-A7_900M-SYSBUS_300M

发布表格支持的 DDR 规格如表 3-1 所示。

表3-1 发布表格支持的 DDR 规格

Uboot 表格	总容量/总位 宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单颗 粒位宽*数量)	单颗 DDR 容量
DMEB uboot 表格 (2133Mbps)	1GB/3325it or 512MB/32bit	通道 0	DDR3	2133	1	16bit*2	4Gbit or 2Gbit
DMEB uboot 表格 (1800Mbps)	1GB/32bit or 512MB/32bit	通道 0	DDR3	1800	1	16bit*2	4Gbit or 2Gbit
DMEBPRO uboot 表格	1GB/32bit or 512MB/32bit	通道 0	DDR3	1800	1	16bit*2	4Gbit or 2Gbit

□ 说明

如果基于某个表格支持的 DDR 规格,同时减小每个 DDR 颗粒的容量,而且每个 DDR 颗粒的容量相同,可以不用修改配置。

3.2 DMEB (2133Mbps) 单板容量修改说明

DMEB (2133Mbps)单板默认的 uboot 表格支持单通道,位宽 32bit,单颗粒 4Gbit/2Gbit, 总容量 1Gbyte/512MByte, 如果有涉及到 DDR 容量的变化, 需要对 uboot 表格做相应的修改,下面列举几种常见的容量设计方案及配置修改说明。

表3-2 DMEB(2133Mbps)单板不同容量设计方案

DMEB(2133Mbps) 不同容量方案	总容量/总 位宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单 颗粒位宽*数 量)	单颗 DDR 容量
方案一	512M/16bit or 256MB/16bit	通道 0	DDR3	2133	1	16bit*1	4Gbit or 2Gbit

DMEB(2133Mbps)方案一配置说明 DMEB(2133Mbps)方案一的设计需要基于默认。 The state of the s 3.2.1 DMEB(2133Mbps)方案一配置说明

位宽的修改

Uboot 表格中的 ddrc 页面原始配置:

		<u>()</u>	<u>, </u>				
DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10226han	0	write	31	0	0x0000000FD
		en tright					
修改后的	力配置:	anthe					

DMC0_CFG_DDRMODE	0x80 50⁽	0xC10216	0	write	31	0	0x000000FD
------------------	----------------------------	----------	---	-------	----	---	------------

高 16bit 禁止

Uboot 表格中的 ddrphy0 页面原始配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80000	0	write	31	0	0x0000000FD
DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80000	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc300	0x2501FF01	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x2501FF01	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
---------------	--------	----------	---	-------	----	---	-------------

DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc300	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD

3.3 DMEB(1800Mbps)单板容量修改说明

DMEB (1800Mbps)单板默认的 uboot 表格支持单通道,位宽 32bit, 单颗粒 4Gbit/2Gbit, 总容量 1Gbyte/512MByte, 如果有涉及到 DDR 容量的变化,需要对 uboot 表格做相应的修改,下面列举几种常见的容量设计方案及配置修改说明。

表3-3 DMEB(1800Mbps)单板不同容量设计方案

		1				•	
DMEB(1800Mbps) 不同容量方案	总容量/总 位宽	通道	DDR 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量 ⁰	o. PDR 位宽(单 颗粒位宽*数 量)	单颗 DDR 容量
方案一	512M/16bit or 256MB/16bit	通道 0	DDR3	1800 Industrial	1	16bit*1	4Gbit or 2Gbit

3.3.1 DMEB(1800Mbps)方案一配置说明

DMEB(1800Mbps)方案一的设计需要基于默认 uboot 表格做如下修改。

位宽的修改

Uboot 表格束的 ddrc 页面原始配置:

DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10226	0	write	31	0	0x0000000FD
------------------	--------	----------	---	-------	----	---	-------------

修改后的配置:

DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10216	0	write	31	0	0x0000000FD
------------------	--------	----------	---	-------	----	---	-------------

高 16bit 禁止

Uboot 表格中的 ddrphy0 页面原始配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80000	0	write	31	0	0x0000000FD
DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80000	0	write	31	0	0x0000000FD

DXNBISTCTRL	0xc300	0x2501FF01	0	write	31	0	0x000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x2501FF01	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc300	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD

3.4 DMEBPRO 单板容量修改说明

PRO 单板容量修改说明

DMEBPRO 单板默认的 uboot 表格支持单通道,位置 32bit,单颗粒 4Gbit/2Gbit,总容量 1GByte/512MByte,加思有涉及到 DDD 容量的变化。需要对 1、表格是自己性的 量 1GByte/512MByte,如果有涉及到 DDR 容量的变化,需要对 uboot 表格做相应的修 改,下面列举几种常见的容量设计方案及配置修改说明。

表3-4 DMEBPRO 单板不同容量设计方案

DMEBPRO 不 同容量方案	总容量/总位 宽	通道	DDRn ³ 类型	DDR 速率 (Mbps)	Rank 数量	DDR 位宽(单 颗粒位宽*数 量)	单颗 DDR 容量
方案一	512MB/16bit or 256MB/16bit	可模。	DDR3	1800	1	16bit*1	4Gbit or 2Gbit

3.4.1 DMEBPRO 方案一

DMEBPRO 方案一的设计需要基于默认 uboot 表格做如下修改。

位宽的修改

Uboot 表格中的 ddrc 页面原始配置:

	DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10226	0	write	31	0	0x0000000FD	
--	------------------	--------	----------	---	-------	----	---	-------------	--

修改后的配置:

DMC0_CFG_DDRMODE	0x8050	0xC10216	0	write	31	0	0x0000000FD
------------------	--------	----------	---	-------	----	---	-------------

高 16bit 禁止

Uboot 表格中的 ddrphy0 页面原始配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80000	0	write	31	0	0x000000FD
DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80000	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc300	0x2501FF01	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x2501FF01	0	write	31	0	0x0000000FD

修改后的配置:

DXCTRL(BYTE2)	0xc308	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
DXCTRL(BYTE3)	0xc388	0xf80003	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc300	0x0	0	write	31	0	0x0000000FD
DXNBISTCTRL	0xc380	0x0	0	write w	31	0	0x000000FD

Cogating only for sheathen from the trial Test